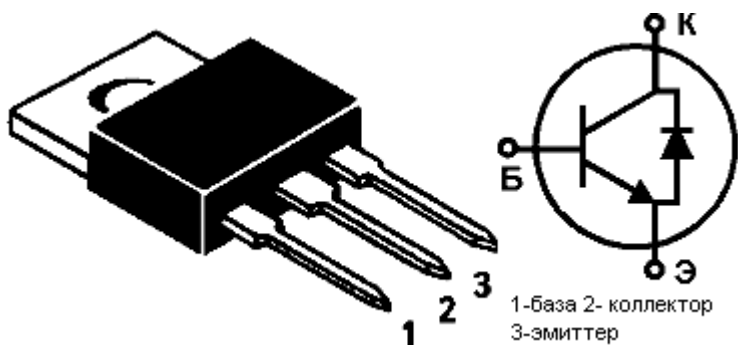


ПИР-1. NPN кремниевый мощный высоковольтный транзистор

Краткий информационный лист



Предназначен для использования в быстродействующих схемах переключения с индуктивной нагрузкой, в импульсных схемах, а также в усилителях мощности с высокой линейностью. Имеет встроенный диод в цепи коллектор-эмиттер.

Максимально-допустимые параметры

Наименование параметра	Обозначение	Величина	Ед.изм.
Напряжение коллектор-база	U_{CBO}	850	В
Напряжение коллектор-эмиттер ($I_B=0$)	U_{CEO}	450	В
Напряжение эмиттер-база	U_{EB}	7	В
Постоянный ток коллектора	I_C	20	А
Импульсный ток коллектора	I_{CM}	30	А
Постоянный ток базы	I_B	5	А
Импульсный ток базы	I_{BM}	15	А
Постоянная рассеиваемая мощность	P_D	125*	Вт
Диапазон рабочих температур перехода	ΔT_j	-55 до +150	С
Максимальная температура перехода	$T_{j \max}$	+150	С

* - при $T_{корп} = +25 \text{ С}$

Электрические характеристики

Наименование параметра, режим измерения	Обозначение	Величина		Ед. изм.
		мин.	макс.	
Граничное напряжение коллектор-эмиттер ($I_C=200\text{mA}$, $I_B=0$)	$U_{CEO(sus)}$	450		В
Обратный ток коллектор-база ($U_{CB}=850\text{В}$)	I_{CBO}		0.5	мА
Обратный ток эмиттер-база ($U_{EB}=6\text{В}$)	I_{EBO}		0.1	мА
Статический коэффициент передачи тока ($U_{CE}=5\text{В}$, $I_C=10\text{А}$)	h_{FE}	8		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_C=10\text{А}$, $I_B=2\text{А}$)	$U_{CE(sat)}$		1.3	В
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_C=10\text{А}$, $I_B=2\text{А}$)	$U_{BE(sat)}$		1.5	В
Прямое напряжение на диоде коллектор-эмиттер ($I_{PP}=30\text{А}$)	U_{PP}		2	В
Емкость перехода коллектор-база ($U_C=10\text{В}$, $I_B=0$, $f=1\text{МГц}$)	C_{OB}		400	пФ

Близкими зарубежными аналогами транзистора "Пир-1" являются приборы BUV-48, MJ13333, MJW16010, MJW16110 фирмы MOTOROLA. Ориентировочная оптовая цена на II кв. 1999 г. - 25 руб. 80 коп. Возможна поставка транзисторов в корпусе КТ9 (ТО-3)